



LEC GaSb n型・p型 基板 標準仕様

ドーパント、導電型	Teドーパ (n型)	Unドーパ (p型)	Znドーパ (p型)
サイズ	2インチ 3インチ 4インチ		
面方位	(100) ± 0.5°		
	(311) A, B ± 0.5° (111) A, B ± 0.5°		

キャリア濃度 (cm ⁻³)	(2.0~10.0) × 10 ¹⁷	(1.0~2.0) × 10 ¹⁷	(3.0~10.0) × 10 ¹⁷
モビリティ (cm ² /V.S)	(1.5~3.6) × 10 ³	(6.0~8.0) × 10 ²	(5.0~7.0) × 10 ²
EPD (Ave) (cm ²)	≦ 1,000	≦ 2,000	≦ 3,000

直径 (mm)	50.8 ± 0.5	76.2 ± 0.5	100.0 ± 0.5
厚さ (μm)	500 ± 25	625 ± 25	725 ± 25
TTV (μm)	≦ 20	≦ 20	≦ 20
Warp (μm)	≦ 15	≦ 15	≦ 15
OF長さ (mm)	17.0 ± 1.0	22.0 ± 1.0	32.5 ± 1.0
IF長さ (mm)	7.0 ± 1.0	12.0 ± 1.0	18.0 ± 1.0

レーザーマーク	オプション		
面仕上げ	表面	鏡面研磨 (エピレディ)	
	裏面	エッチド / 鏡面研磨	
梱包形態	個別トレイ		

※各種ウエハーの仕様はご相談に応じます。

※p型、n型の低キャリア濃度もございます。(10¹⁵~10¹⁶cm⁻³)